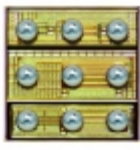
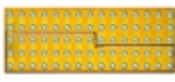
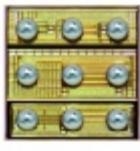
 Image may be representation. See specs for product details.	EPC2106															
	<table><tr><td>Hersteller-Teilenummer:</td><td>EPC2106</td></tr><tr><td>Hersteller / Marke:</td><td>EPC</td></tr><tr><td>Teil der Beschreibung:</td><td>TRANS GAN SYM 100V BUMPED DIE</td></tr><tr><td>Datenblätter:</td><td> EPC2106.pdf</td></tr><tr><td>RoHs Status:</td><td>Bleifrei / RoHS-konform</td></tr><tr><td>Lagerzustand:</td><td>New original, 10464 pcs Stock Available.</td></tr><tr><td>Liefern von:</td><td>Hong Kong</td></tr><tr><td>Versandweg:</td><td>DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</td></tr></table>	Hersteller-Teilenummer:	EPC2106	Hersteller / Marke:	EPC	Teil der Beschreibung:	TRANS GAN SYM 100V BUMPED DIE	Datenblätter:	 EPC2106.pdf	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	Lagerzustand:	New original, 10464 pcs Stock Available.	Liefern von:	Hong Kong	Versandweg:
Hersteller-Teilenummer:	EPC2106															
Hersteller / Marke:	EPC															
Teil der Beschreibung:	TRANS GAN SYM 100V BUMPED DIE															
Datenblätter:	 EPC2106.pdf															
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform															
Lagerzustand:	New original, 10464 pcs Stock Available.															
Liefern von:	Hong Kong															
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS															

Spezifikationen

Teilenummer	EPC2106
Hersteller	EPC
Beschreibung	TRANS GAN SYM 100V BUMPED DIE
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	10464 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 600µA
Supplier Device-Gehäuse	Die
Serie	eGaN®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	70 mOhm @ 2A, 5V
Leistung - max	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	Die
Andere Namen	917-1110-2
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	14 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	75pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	0.73nC @ 5V
Typ FET	2 N-Channel (Half Bridge)
FET-Merkmal	GaNFET (Gallium Nitride)
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Half Bridge) 100V 1.7A
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.7A

Sie können auch interessiert

sein:  EPC2105ENGRT EPC MOSFET 2NCH 80V 9.5A DIE	 EPC2105 EPC TRANS GAN ASYMMETRICAL HALF BRID	 EPC2108ENGRT EPC TRANS GAN 3N-CH BUMPED DIE	 EPC2105ENG EPC TRANS GAN 2N-CH 80V BUMPED DIE
 EPC2107 EPC MOSFET 3 N-CH 100V 9BGA	 EPC2104ENGRT EPC MOSFET 2NCH 100V 23A DIE	 EPC2107ENGRT EPC TRANS GAN 3N-CH 100V BUMPED DIE	 EPC2108 EPC MOSFET 3 N-CH 60V/100V 9BGA

EPC2106 Zugehöriges

Schlüsselwort	EPC2106 Datenblatt	EPC2106-Datenblätter	EPC2106 PDF	EPC EPC2106
EPC2106 Electronic	EPC2106-Komponenten	EPC2106-Verteiler	EPC2106-Bild	EPC2106-Teil
EPC2106 Preis	EPC2106 Hersteller	EPC2106 Bild	EPC2106 Aktie	EPC2106 Inventar
EPC2106 Neu	EPC2106 Original	EPC2106 garantiert	EPC2106 RFQ	EPC2106 Online bestellen